МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»
(ТУСУР)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР
_____Сенченко П.В.
«22» _____02_____ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ЭЛЕКТРОНИКА

Уровень образования: **высшее образование - бакалавриат**
Направление подготовки / специальность: **11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи**
Направленность (профиль) / специализация: **Системы беспроводной связи и "Интернета вещей"**
Форма обучения: **очная**
Факультет: **Радиотехнический факультет (РТФ)**
Кафедра: **Кафедра телекоммуникаций и основ радиотехники (ТОР)**
Курс: **2**
Семестр: **3**
Учебный план набора 2023 года

Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Виды учебной деятельности	3 семестр	Всего	Единицы
Лекционные занятия	26	26	часов
Практические занятия	26	26	часов
Лабораторные занятия	20	20	часов
Самостоятельная работа	72	72	часов
Подготовка и сдача экзамена	36	36	часов
Общая трудоемкость (включая промежуточную аттестацию)	180	180	часов
	5	5	з.е.

Формы промежуточной аттестация	Семестр
Экзамен	3

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сенченко П.В.
Должность: Проректор по УР
Дата подписания: 22.02.2023
Уникальный программный ключ:
a1119608-cdff-4455-b54e-5235117c185c

Томск

Согласована на портале № 74041

1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

1. Целью преподавания дисциплины является изучение студентами элементной базы, применяемой в многоканальных телекоммуникационных системах, телевизионной, радиорелейной, тропосферной, космической и радиолокационной связи.

1.2. Задачи дисциплины

1. Изучение принципов действия, характеристик, параметров и особенностей устройства важнейших полупроводниковых, электровакуумных и оптоэлектронных приборов, используемых в аудиовизуальной технике. К их числу относятся диоды, биполярных и полевые транзисторы, приборы с отрицательной дифференциальной проводимостью, оптоэлектронные и электровакуумные приборы, элементы интегральных схем и основы технологии их производства.
2. Изучение главных элементов цифровой и аналоговой схемотехники, выполненных на основе полупроводниковых, электровакуумных и оптоэлектронных приборов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).
Часть блока дисциплин: Обязательная часть.
Модуль дисциплин: Модуль направления подготовки (special hard skills – SHS).
Индекс дисциплины: Б1.О.03.04.
Реализуется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):
Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
Универсальные компетенции		
-	-	-
Общепрофессиональные компетенции		
ОПК-1. Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности	ОПК-1.1. Знает фундаментальные законы естественных наук и математики	Знать фундаментальные законы полупроводниковых приборов
	ОПК-1.2. Умеет анализировать проблемы, процессы и явления в области физики, использовать на практике базовые знания и методы физических исследований, а также умеет применять методы решения математических задач в профессиональной области	Уметь анализировать процессы и явления в полупроводниковых приборах
	ОПК-1.3. Владеет практическими навыками решения инженерных задач	Владеть практическими навыками построения характеристик и вычисления параметров полупроводниковых приборов
Профессиональные компетенции		

Согласована на портале № 74041

ПК-2. Способен выполнять расчет и проектирование элементов и устройств инфокоммуникационных систем в соответствии с техническим заданием, в том числе с использованием средств автоматизации проектирования	ПК-2.1. Знает методы расчёта и проектирования деталей, узлов и устройств радиоэлектронной аппаратуры	Знать типовые методы расчёта полупроводниковых приборов
	ПК-2.2. Умеет рассчитывать и проектировать узлы и устройства радиотехнических систем в соответствии с заданным техническим заданием с применением средств автоматизированного проектирования	Уметь проектировать элементы полупроводниковых приборов
	ПК-2.3. Владеет навыкам расчёта и проектирования деталей, узлов и устройств радиотехнических систем	Владеть навыкам расчёта и проектирования полупроводниковых приборов

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов.

Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной деятельности представлено в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности

Виды учебной деятельности	Всего часов	Семестры
		3 семестр
Контактная аудиторная работа обучающихся с преподавателем, всего	72	72
Лекционные занятия	26	26
Практические занятия	26	26
Лабораторные занятия	20	20
Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. контактная внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем, всего	72	72
Подготовка к тестированию	22	22
Подготовка к выступлению (докладу)	4	4
Подготовка к контрольной работе	28	28
Подготовка к лабораторной работе, написание отчета	18	18
Подготовка и сдача экзамена	36	36
Общая трудоемкость (в часах)	180	180
Общая трудоемкость (в з.е.)	5	5

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы (темы) дисциплины и виды учебной деятельности

Структура дисциплины по разделам (темам) и видам учебной деятельности приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Разделы (темы) дисциплины и виды учебной деятельности

Названия разделов (тем) дисциплины	Лек. зан., ч	Прак. зан., ч	Лаб. раб.	Сам. раб., ч	Всего часов (без экзамена)	Формируемые компетенции

Согласована на портале № 74041

3 семестр						
1 Введение в физику полупроводников.	2	2	-	2	6	ОПК-1
2 Физические процессы при контакте разнородных материалов (p-n- переход, контакт металл-полупроводник, гетеропереход).	4	4	4	14	26	ОПК-1, ПК-2
3 Физические процессы в структуре с двумя взаимодействующими p-n переходами и её статические характеристики.	2	4	4	10	20	ОПК-1, ПК-2
4 Физические процессы в структуре металл- диэлектрик-полупроводник и её статические характеристики.	2	4	4	10	20	ОПК-1, ПК-2
5 Физические основы управления током канала с помощью управляющего p-n перехода.	2	4	-	8	14	ОПК-1, ПК-2
6 Фотоэлектрические явления в полупроводниках.	3	2	-	6	11	ОПК-1, ПК-2
7 Логические элементы И, ИЛИ, НЕ. Основные характеристики и параметры логических элементов.	4	4	4	10	22	ОПК-1, ПК-2
8 Особенности работы биполярных и полевых транзисторов в ключевых режимах и логических схемах	4	2	4	10	20	ОПК-1, ПК-2
9 Математическое описание моделей полупроводниковых приборов	3	-	-	2	5	ОПК-1, ПК-2
Итого за семестр	26	26	20	72	144	
Итого	26	26	20	72	144	

5.2. Содержание разделов (тем) дисциплины

Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям) приведено в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям)

Названия разделов (тем) дисциплины	Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям)	Трудоемкость (лекционные занятия), ч	Формируемые компетенции
3 семестр			
1 Введение в физику полупроводников.	Собственные и примесные полупроводники. Зонная теория полупроводников. Основные и неосновные носители заряда в примесных полупроводниках	2	ОПК-1
	Итого	2	

Согласована на портале № 74041

2 Физические процессы при контакте разнородных материалов (p-n- переход, контакт металл-полупроводник, гетеропереход).	Плоскостной p-n переход. Формирование потенциального барьера на границе раздела p-n слоёв полупроводников. Контактные явления на границе раздела металл-полупроводник. Полупроводниковые диоды.	4	ОПК-1, ПК-2
	Итого	4	
3 Физические процессы в структуре с двумя взаимодействующими p-n переходами и её статические характеристики.	Биполярные транзисторы npn и pnp. Принцип работы, вольт-амперные характеристики, параметры для трёх схем включения. Составные транзисторы.	2	ОПК-1, ПК-2
	Итого	2	
4 Физические процессы в структуре металл- диэлектрик-полупроводник и её статические характеристики.	Полевые МДП транзисторы с встроенными и индуцированными каналами. Принцип работы, вольт-амперные характеристики, параметры для трёх схем включения.	2	ОПК-1, ПК-2
	Итого	2	
5 Физические основы управления током канала с помощью управляющего p-n перехода.	Полевые транзисторы с p и n каналами и управляющим p-n переходом. Принцип работы, вольт-амперные характеристики, параметры в трёх схемах включения.	2	ОПК-1, ПК-2
	Итого	2	
6 Фотоэлектрические явления в полупроводниках.	Светодиоды и фотодиоды, их принцип работы, вольт-амперные характеристики, параметры. Диодные и транзисторные оптопары.	3	ОПК-1, ПК-2
	Итого	3	
7 Логические элементы И, ИЛИ, НЕ. Основные характеристики и параметры логических элементов.	Принципы построения логических элементов на диодах, биполярных и полевых транзисторах.	4	ОПК-1, ПК-2
	Итого	4	
8 Особенности работы биполярных и полевых транзисторов в ключевых режимах и логических схемах	Переходные процессы в схемах логического отрицания, умножения и суммирования на биполярных и полевых транзисторах.	4	ОПК-1, ПК-2
	Итого	4	

Согласована на портале № 74041

9 Математическое описание моделей полупроводниковых приборов	Физические и математические модели полупроводниковых приборов	3	ОПК-1, ПК-2
	Итого	3	
Итого за семестр		26	
Итого		26	

5.3. Практические занятия (семинары)

Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 5.3.

Таблица 5.3. – Наименование практических занятий (семинаров)

Названия разделов (тем) дисциплины	Наименование практических занятий (семинаров)	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
3 семестр			
1 Введение в физику полупроводников.	Структура и особенности работы p-n перехода при прямом и обратном включении.	2	ОПК-1
	Итого	2	
2 Физические процессы при контакте разнородных материалов (p-n- переход, контакт металл-полупроводник, гетеропереход).	Плоскостные и точечные диоды, диоды Шотки и Ганна, и другие разновидности диодов.	4	ОПК-1
	Итого	4	
3 Физические процессы в структуре с двумя взаимодействующими p-n переходами и её статические характеристики.	Биполярные транзисторы npn и pnp. Особенности работы в трёх схемах включения. Аналоговый и ключевой режимы.	4	ОПК-1
	Итого	4	
4 Физические процессы в структуре металл- диэлектрик-полупроводник и её статические характеристики.	МДП транзисторы с встроенными и индуцированными каналами в трёх схемах включения. Аналоговый и ключевой режимы.	4	ОПК-1
	Итого	4	
5 Физические основы управления током канала с помощью управляющего p-n перехода.	Полевые транзисторы с управляющим p-n переходами в трёх схемах включения. Аналоговый и ключевой режимы.	4	ОПК-1
	Итого	4	
6 Фотоэлектрические явления в полупроводниках.	Свето- и фотодиоды. Диодные и транзисторные оптроны. Фотогальванические полупроводниковые приборы.	2	ОПК-1
	Итого	2	

Согласована на портале № 74041

7 Логические элементы И, ИЛИ, НЕ. Основные характеристики и параметры логических элементов.	Логические элементы на биполярных транзисторах.	4	ОПК-1
	Итого	4	
8 Особенности работы биполярных и полевых транзисторов в ключевых режимах и логических схемах	Переходные процессы в логических элементах. Быстродействующие логические элементы. Запоминающие устройства на биполярных и полевых транзисторах. Запоминающие устройств на полевых транзисторах с плавающим затвором.	2	ОПК-1
	Итого	2	
	Итого за семестр	26	
	Итого	26	

5.4. Лабораторные занятия

Наименование лабораторных работ приведено в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Наименование лабораторных работ

Названия разделов (тем) дисциплины	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
3 семестр			
2 Физические процессы при контакте разнородных материалов (p-n- переход, контакт металл-полупроводник, гетеропереход).	Исследование вольт-амперных характеристик полупроводниковых диодов, определение параметров исследуемых диодов.	4	ОПК-1
	Итого	4	
3 Физические процессы в структуре с двумя взаимодействующими p-n переходами и её статические характеристики.	Исследование вольт-амперных характеристик и определение параметров биполярных транзисторов.	4	ОПК-1
	Итого	4	
4 Физические процессы в структуре металл- диэлектрик-полупроводник и её статические характеристики.	Исследование вольт-амперных характеристик и оценка параметров полевых транзисторов	4	ОПК-1
	Итого	4	
7 Логические элементы И, ИЛИ, НЕ. Основные характеристики и параметры логических элементов.	Исследование характеристик интегральных схем ТТЛ и КМДП	4	ОПК-1
	Итого	4	

Согласована на портале № 74041

8 Особенности работы биполярных и полевых транзисторов в ключевых режимах и логических схемах	Исследование быстродействия насыщенного и ненасыщенного ключа на биполярных транзисторах	4	ОПК-1
	Итого	4	
Итого за семестр		20	
Итого		20	

5.5. Курсовой проект / курсовая работа

Не предусмотрено учебным планом

5.6. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в таблице 5.6.

Таблица 5.6. – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции

Названия разделов (тем) дисциплины	Виды самостоятельной работы	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции	Формы контроля
3 семестр				
1 Введение в физику полупроводников.	Подготовка к тестированию	2	ОПК-1	Тестирование
	Итого	2		
2 Физические процессы при контакте разнородных материалов (p-n- переход, контакт металл-полупроводник, гетеропереход).	Подготовка к тестированию	4	ОПК-1, ПК-2	Тестирование
	Подготовка к выступлению (докладу)	4	ОПК-1	Выступление (доклад) на занятии
	Подготовка к контрольной работе	4	ОПК-1	Контрольная работа
	Подготовка к лабораторной работе, написание отчета	2	ОПК-1	Лабораторная работа
	Итого	14		
3 Физические процессы в структуре с двумя взаимодействующими p-n переходами и её статические характеристики.	Подготовка к лабораторной работе, написание отчета	4	ОПК-1	Лабораторная работа
	Подготовка к тестированию	2	ОПК-1, ПК-2	Тестирование
	Подготовка к контрольной работе	4	ОПК-1	Контрольная работа
	Итого	10		

Согласована на портале № 74041

4 Физические процессы в структуре металл-диэлектрик-полупроводник и её статические характеристики.	Подготовка к тестированию	2	ОПК-1, ПК-2	Тестирование
	Подготовка к контрольной работе	4	ОПК-1	Контрольная работа
	Подготовка к лабораторной работе, написание отчета	4	ОПК-1	Лабораторная работа
	Итого	10		
5 Физические основы управления током канала с помощью управляющего p-n перехода.	Подготовка к тестированию	4	ОПК-1, ПК-2	Тестирование
	Подготовка к контрольной работе	4	ОПК-1	Контрольная работа
	Итого	8		
6 Фотоэлектрические явления в полупроводниках.	Подготовка к тестированию	2	ОПК-1, ПК-2	Тестирование
	Подготовка к контрольной работе	4	ОПК-1	Контрольная работа
	Итого	6		
7 Логические элементы И, ИЛИ, НЕ. Основные характеристики и параметры логических элементов.	Подготовка к тестированию	2	ОПК-1, ПК-2	Тестирование
	Подготовка к контрольной работе	4	ОПК-1	Контрольная работа
	Подготовка к лабораторной работе, написание отчета	4	ОПК-1	Лабораторная работа
	Итого	10		
8 Особенности работы биполярных и полевых транзисторов в ключевых режимах и логических схемах	Подготовка к тестированию	2	ОПК-1, ПК-2	Тестирование
	Подготовка к контрольной работе	4	ОПК-1	Контрольная работа
	Подготовка к лабораторной работе, написание отчета	4	ОПК-1	Лабораторная работа
	Итого	10		
9 Математическое описание моделей полупроводниковых приборов	Подготовка к тестированию	2	ОПК-1, ПК-2	Тестирование
	Итого	2		
Итого за семестр		72		
	Подготовка и сдача экзамена	36		Экзамен
Итого		108		

Согласована на портале № 74041

5.7. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов учебной деятельности

Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов учебной деятельности представлено в таблице 5.7.

Таблица 5.7 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Формируемые компетенции	Виды учебной деятельности				Формы контроля
	Лек. зан.	Прак. зан.	Лаб. раб.	Сам. раб.	
ОПК-1	+	+	+	+	Выступление (доклад) на занятии, Контрольная работа, Лабораторная работа, Тестирование, Экзамен
ПК-2	+			+	Тестирование, Экзамен

6. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся

6.1. Балльные оценки для форм контроля

Балльные оценки для форм контроля представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Балльные оценки

Формы контроля	Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра	Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ	Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра	Всего за семестр
3 семестр				
Выступление (доклад) на занятии	10	0	0	10
Контрольная работа	10	10	10	30
Лабораторная работа	5	5	5	15
Тестирование	5	5	5	15
Экзамен				30
Итого максимум за период	30	20	20	100
Нарастающим итогом	30	50	70	100

6.2. Пересчет баллов в оценки за текущий контроль

Пересчет баллов в оценки за текущий контроль представлен в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Пересчет баллов в оценки за текущий контроль

Баллы на дату текущего контроля	Оценка
≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату ТК	5
От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату ТК	4
От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату ТК	3
< 60% от максимальной суммы баллов на дату ТК	2

6.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Оценка	Итоговая сумма баллов, учитывает успешно сданный экзамен	Оценка (ECTS)

Согласована на портале № 74041

5 (отлично) (зачтено)	90 – 100	A (отлично)
4 (хорошо) (зачтено)	85 – 89	B (очень хорошо)
	75 – 84	C (хорошо)
	70 – 74	D (удовлетворительно)
3 (удовлетворительно) (зачтено)	65 – 69	
	60 – 64	E (посредственно)
2 (неудовлетворительно) (не зачтено)	Ниже 60 баллов	F (неудовлетворительно)

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература

1. Электроника. Часть 1: Учебное пособие / В. М. Ицкович, В. А. Шалимов - 2016. 209 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/7278.
2. Электроника. Часть 2: Учебное пособие / В. М. Ицкович, В. А. Шалимов - 2016. 120 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/7279.
3. Электроника: Учебное пособие / В. Ф. Коновалов - 2012. 266 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/7314.

7.2. Дополнительная литература

1. Ефимов, И. Е. Основы микроэлектроники : учебник / И. Е. Ефимов, И. Я. Козырь. — 3-е изд. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-0866-5. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/210218.
2. Гусев В.Г. Электроника: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1991. – 622 с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 73 экз.).
3. Степаненко И.П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем: научное издание. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергия, 1977. – 671 с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 81 экз.).
4. Жеребцов И.П. Основы электроники. – 5-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 53 экз.).

7.3. Учебно-методические пособия

7.3.1. Обязательные учебно-методические пособия

1. Исследование вольт-амперных характеристик полупроводниковых диодов: Руководство к лабораторной работе / А. М. Заболоцкий, В. А. Шалимов - 2018. 11 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/7912.
2. Исследование вольт-амперных характеристик биполярных транзисторов: Руководство к лабораторной работе / А. М. Заболоцкий, В. А. Шалимов - 2018. 9 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/7913.
3. Исследование насыщенного транзисторного ключа: Руководство к лабораторной работе / А. М. Заболоцкий, В. А. Шалимов - 2018. 18 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/7988.
4. Исследование вольт-амперных характеристик полевых транзисторов: Руководство к лабораторной работе / А. М. Заболоцкий, В. А. Шалимов - 2018. 16 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/7914.
5. Исследование базового элемента транзисторно-транзисторной логики: Руководство к лабораторной работе / А. М. Заболоцкий, В. А. Шалимов - 2018. 15 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/7991.
6. Исследование логического элемента на комплементарных полевых транзисторах с индуцированным каналом (КМДП): Руководство к лабораторной работе / А. М. Заболоцкий, В. А. Шалимов - 2018. 15 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/7992.
7. Чурляева, О. Н. Электротехника и электроника : учебное пособие / О. Н. Чурляева, М. А. Левин. — Саратов : Саратовский ГАУ, 2019. — 168 с. — ISBN 978-5-00140-263-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/137526.

Согласована на портале № 74041

7.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

Для лиц с нарушениями зрения:

– в форме электронного документа;

– в печатной форме увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушениями слуха:

– в форме электронного документа;

– в печатной форме.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

– в форме электронного документа;

– в печатной форме.

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. При изучении дисциплины рекомендуется обращаться к современным базам данных, информационно-справочным и поисковым системам, к которым у ТУСУРа открыт доступ: https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh.

8. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

8.1. Материально-техническое и программное обеспечение для лекционных занятий

Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория с достаточным количеством посадочных мест для учебной группы, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются мультимедийное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.

8.2. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий

Учебная лаборатория цифровых устройств и микропроцессоров: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, помещение для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы; 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 218 ауд.

Описание имеющегося оборудования:

- Генераторы: Г3-53 (3 шт.), Г3-112/1 (3 шт.), Г5-54 (6 шт.);
- Осциллографы GOS-620 (6 шт.);
- Макеты (6 шт.);
- Доска аудиторная;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.

8.3. Материально-техническое и программное обеспечение для лабораторных работ

Учебная лаборатория цифровых устройств и микропроцессоров: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, помещение для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы; 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 218 ауд.

Описание имеющегося оборудования:

Согласована на портале № 74041

- Генераторы: Г3-53 (3 шт.), Г3-112/1 (3 шт.), Г5-54 (6 шт.);
- Осциллографы GOS-620 (6 шт.);
- Макеты (6 шт.);
- Доска аудиторная;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.

8.4. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы

Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы), расположенные по адресам:

- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 209 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.

Описание имеющегося оборудования:

- учебная мебель;
- компьютеры;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду ТУСУРа.

Перечень программного обеспечения:

- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.

8.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.

При занятиях с обучающимися с **нарушениями слуха** предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.

При занятиях с обучающимися с **нарушениями зрения** предусмотрено использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра.

При занятиях с обучающимися с **нарушениями опорно-двигательного аппарата** используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.

9. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения дисциплины

9.1. Содержание оценочных материалов для текущего контроля и промежуточной аттестации

Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной компетенций используются оценочные материалы, представленные в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Формы контроля и оценочные материалы

Названия разделов (тем) дисциплины	Формируемые компетенции	Формы контроля	Оценочные материалы (ОМ)

Согласована на портале № 74041

1 Введение в физику полупроводников.	ОПК-1	Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
2 Физические процессы при контакте разнородных материалов (p-n- переход, контакт металл-полупроводник, гетеропереход).	ОПК-1, ПК-2	Выступление (доклад) на занятии	Примерный перечень тем для выступления (доклада) на занятии
		Контрольная работа	Примерный перечень вариантов (заданий) контрольных работ
		Лабораторная работа	Темы лабораторных работ
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
3 Физические процессы в структуре с двумя взаимодействующими p-n переходами и её статические характеристики.	ОПК-1, ПК-2	Контрольная работа	Примерный перечень вариантов (заданий) контрольных работ
		Лабораторная работа	Темы лабораторных работ
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
4 Физические процессы в структуре металл-диэлектрик-полупроводник и её статические характеристики.	ОПК-1, ПК-2	Контрольная работа	Примерный перечень вариантов (заданий) контрольных работ
		Лабораторная работа	Темы лабораторных работ
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
5 Физические основы управления током канала с помощью управляющего p-n перехода.	ОПК-1, ПК-2	Контрольная работа	Примерный перечень вариантов (заданий) контрольных работ
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
6 Фотоэлектрические явления в полупроводниках.	ОПК-1, ПК-2	Контрольная работа	Примерный перечень вариантов (заданий) контрольных работ
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов

Согласована на портале № 74041

7 Логические элементы И, ИЛИ, НЕ. Основные характеристики и параметры логических элементов.	ОПК-1, ПК-2	Контрольная работа	Примерный перечень вариантов (заданий) контрольных работ
		Лабораторная работа	Темы лабораторных работ
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
8 Особенности работы биполярных и полевых транзисторов в ключевых режимах и логических схемах	ОПК-1, ПК-2	Контрольная работа	Примерный перечень вариантов (заданий) контрольных работ
		Лабораторная работа	Темы лабораторных работ
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
9 Математическое описание моделей полупроводниковых приборов	ОПК-1, ПК-2	Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов

Шкала оценки сформированности отдельных планируемых результатов обучения по дисциплине приведена в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Шкала оценки сформированности планируемых результатов обучения по дисциплине

Оценка	Баллы за ОМ	Формулировка требований к степени сформированности планируемых результатов обучения		
		знать	уметь	владеть
2 (неудовлетворительно)	< 60% от максимальной суммы баллов	отсутствие знаний или фрагментарные знания	отсутствие умений или частично освоенное умение	отсутствие навыков или фрагментарные применение навыков
3 (удовлетворительно)	от 60% до 69% от максимальной суммы баллов	общие, но не структурированные знания	в целом успешно, но не систематически осуществляемое умение	в целом успешное, но не систематическое применение навыков
4 (хорошо)	от 70% до 89% от максимальной суммы баллов	сформированные, но содержащие отдельные проблемы знания	в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение	в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы применение навыков

Согласована на портале № 74041

5 (отлично)	≥ 90% от максимальной суммы баллов	сформированные систематические знания	сформированное умение	успешное и систематическое применение навыков

Шкала комплексной оценки сформированности компетенций приведена в таблице 9.3.

Таблица 9.3 – Шкала комплексной оценки сформированности компетенций

Оценка	Формулировка требований к степени компетенции
2 (неудовлетворительно)	Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале или Знать на уровне **ориентирования**, представлений. Обучающийся знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
3 (удовлетворительно)	Знать и уметь на **репродуктивном** уровне. Обучающихся знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
4 (хорошо)	Знать, уметь, владеть на **аналитическом** уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
5 (отлично)	Знать, уметь, владеть на **системном** уровне. Обучающийся знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания дисциплины, его значимость в содержании дисциплины.

9.1.1. Примерный перечень тестовых заданий

1. Полупроводниковый диод включен в обратном направлении. При увеличении запирающего напряжения ширина p-n перехода:
   а) Увеличивается.
   б) Равна 0.
   в) Уменьшается.
   г) Остается неизменной.
2. Полупроводниковый диод включен в обратном направлении. При уменьшении запирающего напряжения величина барьерной емкости:
   а) Уменьшается.
   б) Остается неизменной.
   в) Увеличивается.
   г) Стремиться к 0.
3. Какие типы полупроводниковых материалов используются при создании p-n переходов:
   а) «n» полупроводниковые материалы.
   б) «p» полупроводниковые материалы.
   в) «i» полупроводниковые материалы.
   г) «p-n».
4. Какой полупроводниковый материал обеспечивает наибольшую рабочую температуру:
   а) Ge.
   б) Si.
   в) GaAs.
   г).GaN.

Согласована на портале № 74041

5. Для чего одну из областей p-n перехода выполняют относительно, высокоомной:
   а) Для увеличения быстродействия.
   б) Для увеличения максимального тока.
   в) Для увеличения напряжения пробоя.
   г) Для уменьшения напряжения пробоя.
6. При каком включении диода на p-n переходе выделяется наибольшая мощность:
   а) Обратном.
   б) Прямом.
   в) В области пробоя.
   г) В импульсном режиме.
7. Как меняется емкость p-n перехода при обратном включении и увеличении запирающего напряжения:
   а) Увеличивается.
   б) Не меняется.
   в) Равно 0.
   г) Уменьшается.
8. В какой схеме включения биполярные транзисторы имеют максимальный коэффициент усиления по мощности:
   а) ОБ.
   б) ОК.
   в) ОЭ.
   г) ОИ
9. При каком включении диода на p-n переходе выделяется наименьшая мощность:
   а) Обратном.
   б) Прямом.
   в) В области пробоя.
   г) В импульсном режиме.
10. В какой схеме включения биполярные транзисторы имеют максимальное входное сопротивление:
    а) ОБ.
    б) ОК.
    в) ОЭ.
    г) ОИ
11. В какой схеме включения биполярные транзисторы имеют наилучшие частотные свойства:
    а) ОБ.
    б) ОК.
    в) ОЭ.
    г) ОИ
12. В каких режимах могут работать фотодиоды:
    а) Преобразовывать свет-сигнал.
    б) Фотогенераторы.
    в) Преобразовывать переменное напряжение в постоянное.
    г) Автогенератор.
13. Для полевого транзистора с индуцированным «n» каналом в схеме «общий исток» при увеличении отрицательного напряжения на затворе ток стока:
    а) Уменьшается.
    б) Увеличивается.
    в) Остается неизменным.
    г) Равен 0.
14. Для полевого транзистора с встроенным «p» каналом в схеме с общим истоком при увеличении отрицательного напряжения на затворе ток стока:
    а) Уменьшается.
    б) Увеличивается.
    в) Не меняется.
    г) Равен 0.
15. Какой из видов полевых транзисторов обладает наименьшей чувствительностью к

Согласована на портале № 74041

электростатическому пробою:
а) Полевые транзисторы со встроенным каналом.
б) Полевые транзисторы с индуцированным каналом.
в) Полевые транзисторы с «p-n» переходом.
г) Все.

9.1.2. Перечень экзаменационных вопросов

1. Разрешенные и запрещенные энергетические зоны. Собственная электропроводность полупроводника.
2. Примесная электропроводность полупроводника. Акцепторные примеси. Донорные примеси.
3. Процессы переноса зарядов в полупроводниках. Диффузия носителей заряда. Дрейф носителей заряда.
4. Электрические переходы. Электронно-дырочный переход. Вентильное свойство p-n перехода. Емкость p-n перехода. Виды пробоев p-n перехода.
5. Полупроводниковый диод. Классификация диодов. Основные параметры.
6. Стабилитрон.
7. Варикап.
8. Туннельный диод.
9. Диод Шоттки.
10. Точечный диод.
11. Лавинный диод.
12. Импульсный диод.
13. Биполярный транзистор. Структура и основные режимы работы.
14. Физические процессы в биполярном транзисторе. Основные параметры биполярных транзисторов.
15. Схемы включения транзистора. Схема с общей базой. Схема с общим эмиттером. Схема с общим коллектором. Основные параметры, характеризующие эти схемы включения.
16. Статические характеристики биполярного транзистора.
17. Предельные режимы работы транзистора.
18. Влияние температуры на работу усилительных каскадов. Схема эмиттерной стабилизации. Схема коллекторной стабилизации.
19. Составной транзистор. Схемы составного транзистора.
20. Полевой транзистор. Разновидности полевых транзисторов.
21. Основные параметры полевых транзисторов.
22. Физические процессы в полевом транзисторе с управляющим p-n переходом. Статические характеристики.
23. Структуры полевых транзисторов с изолированным затвором (МДП-транзисторы): со встроенным каналом; с индуцированным каналом.
24. Физические процессы в МДП-транзисторах. Статические характеристики.
25. Схемы включения полевых транзисторов.
26. Принципиальная схема ключа на биполярном транзисторе (pnp, npn). Статический режим работы транзисторного ключа.
27. Переходные процессы в ключевых цепях с биполярными транзисторами (Открывание транзисторного ключа, закрывание транзисторного ключа, временные диаграммы токов и напряжений). Как можно уменьшить время рассасывания, длительности фронта и спада в насыщенном ключе.
28. Принципиальная схема транзисторного ключа с ускоряющей емкостью. Объясните, почему включение конденсатора позволяет сократить время рассасывания, длительности фронта и спада.
29. Принципиальная схема транзисторного ключа с нелинейной обратной связью. Объяснить принцип работы
30. Принципиальная схема ключа на n-канальных МДП-транзисторах. Объяснить принцип работы.
31. Принципиальная схема ключа на p-канальных МДП-транзисторах. Объяснить принцип работы.
32. Принципиальная схема ключа на КМДП-структурах. Объяснить принцип работы.

Согласована на портале № 74041

33. h-параметры. Физический смысл коэффициентов. Эквивалентная схема транзистора с учетом h-параметров.
34. y-параметры. Физический смысл коэффициентов. Эквивалентная схема транзистора с учетом y-параметров.
35. Фотоэлектрические приборы на основе внешнего фотоэффекта. Фотоэлемент. Основные характеристики. Основные параметры.
36. Фотоэлектрические приборы на основе внутреннего фотоэффекта. Фотодиод. Способы включения. Принцип действия. Основные характеристики. Основные параметры.
37. Фототранзистор. Принцип действия. Основные характеристики.
38. Светодиод. Структура. Принцип действия.
39. Оптрон.

9.1.3. Примерный перечень тем для выступления (доклада) на занятии

1. Стабилитрон.
2. Варикап.
3. Туннельный диод.
4. Диод Шоттки.
5. Точечный диод.
6. Лавинный диод.
7. Импульсный диод.

9.1.4. Примерный перечень вариантов (заданий) контрольных работ

1. Физические процессы при контакте разнородных материалов.
2. Физические процессы в структуре с двумя взаимодействующими переходами и её статические характеристики.
3. Физические процессы в структуре металл-диэлектрик-полупроводник и её статические характеристики.
4. Физические основы управления током канала с помощью управляющего перехода.
5. Фотоэлектрические явления в полупроводниках.

9.1.5. Темы лабораторных работ

1. Исследование вольт-амперных характеристик полупроводниковых диодов, определение параметров исследуемых диодов.
2. Исследование вольт-амперных характеристик и определение параметров биполярных транзисторов.
3. Исследование вольт-амперных характеристик и оценка параметров полевых транзисторов
4. Исследование характеристик интегральных схем ТТЛ и КМДП
5. Исследование быстродействия насыщенного и ненасыщенного ключа на биполярных транзисторах

9.2. Методические рекомендации

Учебный материал излагается в форме, предполагающей самостоятельное мышление студентов, самообразование. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.

Начать изучение дисциплины необходимо со знакомства с рабочей программой, списком учебно-методического и программного обеспечения. Самостоятельная работа студента включает работу с учебными материалами, выполнение контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом.

В процессе изучения дисциплины для лучшего освоения материала необходимо регулярно обращаться к рекомендуемой литературе и источникам, указанным в учебных материалах; пользоваться через кабинет студента на сайте Университета образовательными ресурсами электронно-библиотечной системы, а также общедоступными интернет-порталами, содержащими научно-популярные и специализированные материалы, посвященные различным аспектам учебной дисциплины.

При самостоятельном изучении тем следуйте рекомендациям:

– чтение или просмотр материала осуществляйте со скоростью, достаточной для

Согласована на портале № 74041

индивидуального понимания и освоения материала, выделяя основные идеи; на основании изученного составить тезисы. Освоив материал, попытаться соотнести теорию с примерами из практики;

– если в тексте встречаются незнакомые или малознакомые термины, следует выяснить их значение для понимания дальнейшего материала;

– осмысливайте прочитанное и изученное, отвечайте на предложенные вопросы.

Студенты могут получать индивидуальные консультации, в т.ч. с использованием средств телекоммуникации.

По дисциплине могут проводиться дополнительные занятия, в т.ч. в форме вебинаров. Расписание вебинаров и записи вебинаров публикуются в электронном курсе / электронном журнале по дисциплине.

9.3. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 9.4.

Таблица 9.4 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Категории обучающихся	Виды дополнительных оценочных материалов	Формы контроля и оценки результатов обучения
С нарушениями слуха	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы	Преимущественно письменная проверка
С нарушениями зрения	Собеседование по вопросам к зачету, опрос по терминам	Преимущественно устная проверка (индивидуально)
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	Решение дистанционных тестов, контрольные работы, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету	Преимущественно дистанционными методами
С ограничениями по общемедицинским показаниям	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы, устные ответы	Преимущественно проверка методами, определяющимися исходя из состояния обучающегося на момент проверки

9.4. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

– в печатной форме;

– в печатной форме с увеличенным шрифтом;

– в форме электронного документа;

– методом чтения ассистентом задания вслух;

– предоставление задания с использованием сурдоперевода.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

– письменно на бумаге;

– набор ответов на компьютере;

– набор ответов с использованием услуг ассистента;

– представление ответов устно.

Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Согласована на портале № 74041

Для лиц с нарушениями зрения:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме.

При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

Согласована на портале № 74041

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ТУ
протокол № 23 от «15» 2 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий выпускающей каф. ТОР	Е.В. Рогожников	Согласовано, b84f9d06-d731-4645-a26c-4b95ce5bb9b9
Заведующий обеспечивающей каф. ТУ	Т.Р. Газизов	Согласовано, dccabe2f-73cc-455a-90f8-2fcc230a841e
И.О. начальника учебного управления	И.А. Лариошина	Согласовано, c3195437-a02f-4972-a7c6-ab6ee1f21e73

ЭКСПЕРТЫ:

Заведующий кафедрой, каф. ТОР	Е.В. Рогожников	Согласовано, 89e0aaec-be8a-4f7b-bd1a-f43585db8135
Старший преподаватель, каф. ТУ	А.В. Бусыгина	Согласовано, 7d0bdef1-6f57-4269-9fbe-4beb03053805

РАЗРАБОТАНО:

Заведующий кафедрой, каф. СВЧиКР	А.М. Заболоцкий	Разработано, 47c2d4ff-8c0e-484c-b856-20e4ba4f0e52

Согласована на портале № 74041